

Сведения об официальном оппоненте
по диссертации Ильченко Степана Николаевича на тему:
«Суперлюминесцентные диоды и полупроводниковый оптический усилитель
повышенной мощности и широкополосности и приборы на их основе» по
специальности: 05.27.03 – «Квантовая электроника» на соискание учёной
степени кандидата технических наук

Фамилия, имя, отчество	Богатов Александр Петрович
Гражданство	РФ
Учёная степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена докторская/кандидатская)	доктор физико – математических наук по специальности 01.04.21 «Лазерная физика»
Полное наименование организации, в которой работает оппонент	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический институт им. П.Н.Лебедева Российской академии наук
Сокращённое наименование организации, в которой работает оппонент	ФИАН
Подразделение	Лаборатория инжекционных лазеров
Должность	Главный научный сотрудник
Ведомственная принадлежность организации	ФАНО России
Почтовый индекс и адрес организации	119991 Москва, Ленинский проспект, д.53
Официальный сайт организации	http://www.lebedev.ru
Адрес электронной почты	postmaster@lebedev.ru
Телефон организации	Телефон: 8(499)135-42-64
Электронная почта оппонента	bogatov@sci.lebedev.ru
Ссылки на публикации последних пяти лет, близкие по тематике к диссертации: 1. Экспериментальное исследование диодного усилителя модулированного пучка на основе AlGaAs/GaAs, работающего в режиме глубокого насыщения усиления Н. В. Дьячков, А. П. Богатов, Т. И. Гущик, А. Е. Дракин <i>Квант. электрон.</i>, 44:11 (2014), 1005–1011 2. Диодный усилитель мощности модулированного оптического пучка Н. В. Дьячков, А. П. Богатов, Т. И. Гущик, А. Е. Дракин <i>Квант. электрон.</i>, 44:11 (2014), 997–1004	

3. Амплитудно-фазовая модуляция излучения в усилителе бегущей волны на основе лазерного диода
А. П. Богатов, Н. В. Дьячков, А. Е. Дракин, Т. И. Гущик
Квант. электрон., **43**:8 (2013), 699–705
4. Измерение параметров Стокса излучения полупроводниковых лазеров
Н. В. Дьячков, А. П. Богатов
Квант. электрон., **41**:10 (2011), 869–874
5. Оценка надежности гетеролазеров при их старении в процессе облучения потоком быстрых частиц
А. П. Богатов, А. А. Кочетков, В. П. Коняев
Квант. электрон., **41**:2 (2011), 99–102
6. Параметры Стокса излучения поперечно-одномодовых InGaAs/AlGaAs-лазеров с квантоворазмерной активной областью
Н. В. Дьячков, А. П. Богатов
Квант. электрон., **41**:1 (2011), 20–25

Официальный оппонент

Главный научный сотрудник ФИАН,
и.о. зав. лаб., д.ф.-м.н., профессор


29.03.2016

Богатов А. П.

Подпись Богатова А. П. заверяю

Ученый секретарь ФИАН, к.ф.-м.н.



Цвентух М.М.

Сведения об официальном оппоненте
по диссертации Ильченко Степана Николаевича на тему:
«Суперлюминесцентные диоды и полупроводниковый оптический усилитель повышенной мощности и широкополосности и приборы на их основе» по специальности: 05.27.03 – «Квантовая электроника»
на соискание учёной степени кандидата технических наук

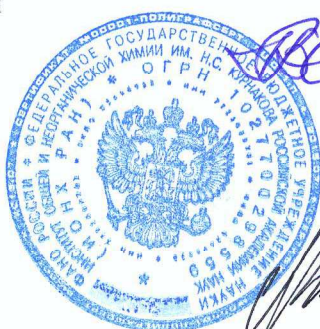
Фамилия, имя, отчество	Васильев Михаил Григорьевич
Гражданство	РФ
Учёная степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена докторская/кандидатская)	доктор технических наук по специальности 05.27.03 «Квантовая электроника»
Полное наименование организации, в которой работает оппонент	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова Российской академии наук
Сокращённое наименование организации, в которой работает оппонент	ИОНХ РАН
Подразделение	Лаборатория полупроводниковых и диэлектрических материалов
Должность	Заведующий лабораторией
Ведомственная принадлежность организации	ФАНО
Почтовый индекс и адрес организации	119991, Москва, Ленинский проспект, д. 31
Официальный сайт организации	http://www.igic.ras.ru/
Адрес электронной почты	info@igic.ras.ru
Телефон организации	Телефон: 8 (495) 952-07-87
Электронная почта оппонента	mgvas@igic.ras.ru

Ссылки на публикации последних пяти лет, близкие по тематике к диссертации:

1. Создание и исследование высокотемпературного лазерного диода с длиной волны излучения 1310 нм на основе зарощенных гетероструктур InP/GaInAsP.
Васильев М.Г., Васильев А.М., Изотов А.Д., Шелякин А.А.
Неорганические материалы, 2014. Т. 50, № 9. С. 963 -967
2. Зарощенный лазерный диод с длиной волны излучения 1310нм, работающий в СВЧ диапазоне
Васильев М.Г., А.М. Васильев, А.Д. Изотов, А.А. Шелякин
Известия, Академия инженерных наук им. А.М. Прохорова, 2013, №2, с. 22 -29
3. Создание и исследование лазерного диода для удаленного определения концентрации метана
Васильев М.Г., А.М. Васильев, А.Д. Изотов, А.А. Шелякин
Неорганические материалы. 2012, т. 48, №3, с. 305-311
4. Пат. RU 2 421 857 С2 Полупроводниковый лазерный излучатель с полосой модуляции в СВЧ - диапазоне / Опубликовано 20.06. 2011 . Бюл. № 17. Васильев М.Г., Белкин М.Е., Шелякин А.А.; заявитель и патентообладатель МИРЭА. Опубликовано 20.06. 2011 . Бюл.№ 17.

Официальный оппонент

Заведующий . лабораторией
ИОНХ РАН,
д.т.н., профессор



Васильев М. Г.